

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 317

Общие данные

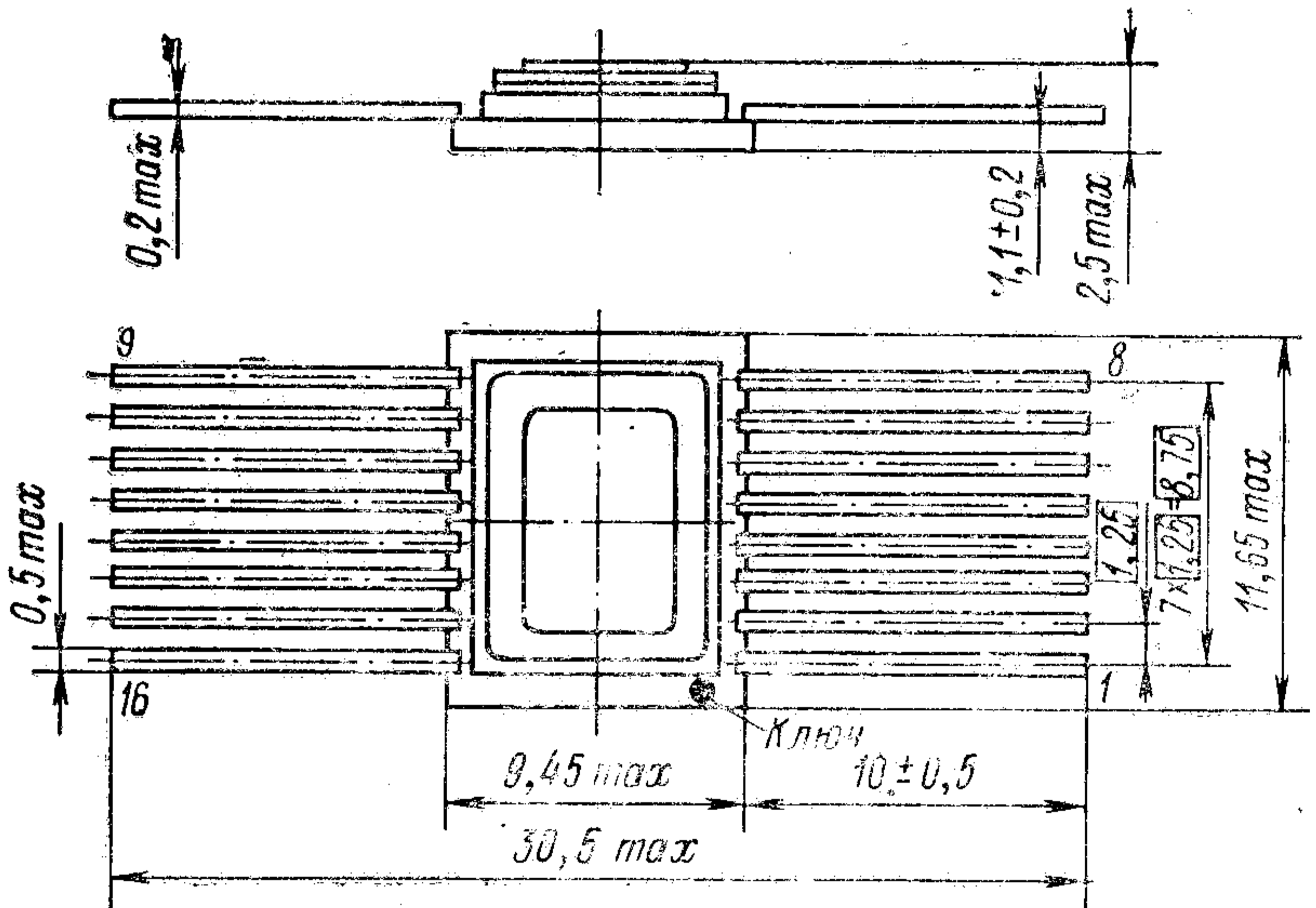
Микросхемы интегральные серии 317 предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии 317

Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение	Обозначение документа на поставку
317НФ1А 317НФ1Б	Делитель напряжения R—2R (двенадцатипятиразрядный)	6К0.347.332 ТУ

Микросхемы выполнены в корпусе 402.16-23.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 1,5 г

Нумерация выводов показана условно.

По согласованию с потребителем допускается применение длины выводов, равной 4,5 мм.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, м·с ⁻² (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g)	1500 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, м·с⁻² (g)

5000 (500)

Акустический шум:

диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	170

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 317

Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	10^{-6} ($1,3 \cdot 10^{-4}$)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С	125
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменения температуры среды, °С	от минус 60 до +125
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ⁰ , ч	25 000
Срок сохраняемости ⁰ , лет	25

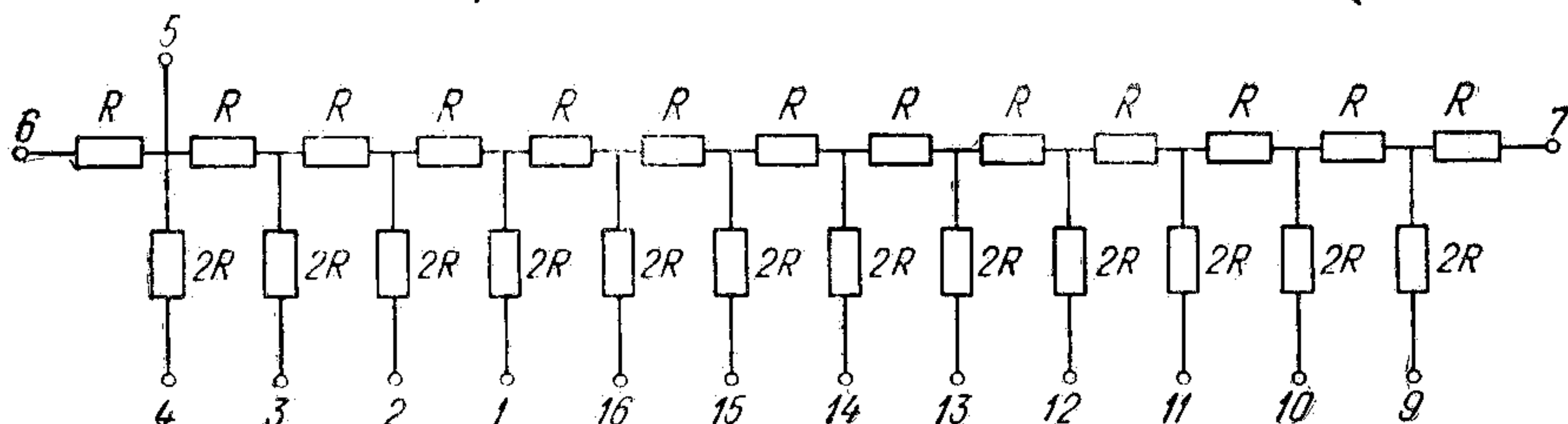
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимая амплитуда импульсного напряжения 100 В при $\tau_n \leq 50$ мс, кратности — 15.

ОВ условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°C)

Величина выходного сопротивления $R_{\text{вых}}^*$, кОм:

для микросхемы 317НФ1А	10±10%
» » 317НФ1Б	15±10%

Эквивалентное сопротивление, кОм:

для микросхемы 317НФ1А	от 9 до 11
» » 317НФ1Б	от 13,5 до 16,5

Допускаемое отклонение коэффициента деления напряжения при $U_{\text{вх}} \leq 12$ В, %, не более

±0,0125

Масштабный коэффициент при $U_{\text{вх}} \leq 12$ В

от 0,99975 до 1,00025

Сопротивление изоляции между каждым выводом 1—7, 9—16 и корпусом, МОм, не менее

1000

Максимальная мощность резистора, мВт:

для микросхемы 317НФ1А	10
» » 317НФ1Б	8

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное входное напряжение, В ±13,2

* $R_{\text{вых}}$ — сопротивление между выводами 5 и остальными выводами, кроме 6, объединенного вместе.